

2Т325Б

Транзисторы кремниевые эпитаксиально-планарные структуры n-p-n усилительные с ненормированным коэффициентом шума.

Предназначены для применения в усилителях высокой частоты.

Выпускаются в металлостеклянном корпусе с гибкими выводами.

Тип приборов 2Т325А, 2Т325Б, 2Т325В, КТ325А, КТ325Б, КТ325В указывается на корпусе.

Масса транзистора не более 1,2 г.

Тип корпуса: КТ-2-3.

Технические условия: СБ0.336.023 ТУ.

Основные технические характеристики транзистора 2Т325Б:

- Структура транзистора: n-p-n;
- $P_{к\ max}$ - Постоянная рассеиваемая мощность коллектора: 225 мВт;
- $f_{гр}$ - Граничная частота коэффициента передачи тока транзистора для схемы с общим эмиттером: не менее 800 МГц;
- $U_{кэ\ max}$ - Максимальное напряжение коллектор-эмиттер при заданном токе коллектора и заданном (конечном) сопротивлении в цепи база-эмиттер: 15 В (3кОм);
- $U_{эб\ max}$ - Максимальное напряжение эмиттер-база при заданном обратном токе эмиттера и разомкнутой цепи коллектора: 4 В;
- $I_{к\ max}$ - Максимально допустимый постоянный ток коллектора: 60 мА;
- $I_{кб\ o}$ - Обратный ток коллектора - ток через коллекторный переход при заданном обратном напряжении коллектор-база и разомкнутом выводе эмиттера: не более 0,5 мкА;
- $h_{21Э}$ - Статический коэффициент передачи тока для схемы с общим эмиттером в режиме большого сигнала: 70... 120;
- $C_{к}$ - Емкость коллекторного перехода: не более 2,50 пФ;
- $t_{к}$ - Постоянная времени цепи обратной связи на высокой частоте: не более 125 пс

Технические характеристики транзисторов 2Т325А, 2Т325Б, 2Т325В:

Тип транзистора	Структура	Предельные значения параметров при $T_{п}=25^{\circ}\text{C}$						Значения параметров при $T_{п}=25^{\circ}\text{C}$						$T_{п\ max}$	T_{max}	
		$I_{к\ max}$	$I_{к\ и.\ max}$	$U_{кэ\ R}$	$U_{кб\ o}$	$U_{эб\ o}$	$P_{к\ max}$	$h_{21Э}$	$U_{к\ э\ на\ с.}$	$I_{кб\ o}$	$f_{гр.}$	$K_{ш}$	$C_{к}$			$C_{э}$
		мА	мА	В	В	В	мВт		В	мкА	МГц	дБ	пФ			пФ
2Т325А	n-p-n	60	60	15	15	4	225	30...90	-	0,5	800	-	2,5	2,5	150	- 60...+125
2Т325Б	n-p-n	60	60	15	15	4	225	70...210	-	0,5	800	-	2,5	2,5	150	- 60...+125

2Т325В	n-p-n	60	60	15	15	4	225	160...4 00	-	0,5	100 0	-	2, 5	2, 5	150	60...+1 25
--------	-------	----	----	----	----	---	-----	---------------	---	-----	----------	---	---------	---------	-----	---------------

Условные обозначения электрических параметров транзисторов:

- **I_{к max}** - максимально допустимый постоянный ток коллектора транзистора.
- **I_{к.и. max}** - максимально допустимый импульсный ток коллектора транзистора.
- **U_{кэR max}** - максимальное напряжение между коллектором и эмиттером при заданном токе коллектора и сопротивлении в цепи база-эмиттер.
- **U_{кэ0 max}** - максимальное напряжение между коллектором и эмиттером транзистора при заданном токе коллектора и токе базы, равным нулю.
- **U_{кб0 max}** - максимальное напряжение коллектор-база при заданном токе коллектора и токе эмиттера, равным нулю.
- **U_{эб0 max}** - максимально допустимое постоянное напряжение эмиттер-база при токе коллектора, равном нулю.
- **P_{к max}** - максимально допустимая постоянная мощность, рассеиваемая на коллекторе транзистора.
- **h_{21Э}** - статический коэффициент передачи тока биполярного транзистора.
- **h_{21э}** - коэффициент передачи тока биполярного транзистора в режиме малого сигнала в схеме с общим эмиттером.
- **U_{кэ нас.}** - напряжение насыщения между коллектором и эмиттером транзистора.
- **I_{кбо}** - обратный ток коллектора. Ток через коллекторный переход при заданном обратном напряжении коллектор-база и разомкнутом выводе эмиттера.
- **f_{гр}** - граничная частота коэффициента передачи тока.
- **K_ш** - коэффициент шума транзистора.
- **C_к** - емкость коллекторного перехода.
- **C_э** - емкость коллекторного перехода.
- **T_{п max}** - максимально допустимая температура перехода.
- **T_{max}** - максимально допустимая температура окружающей среды.